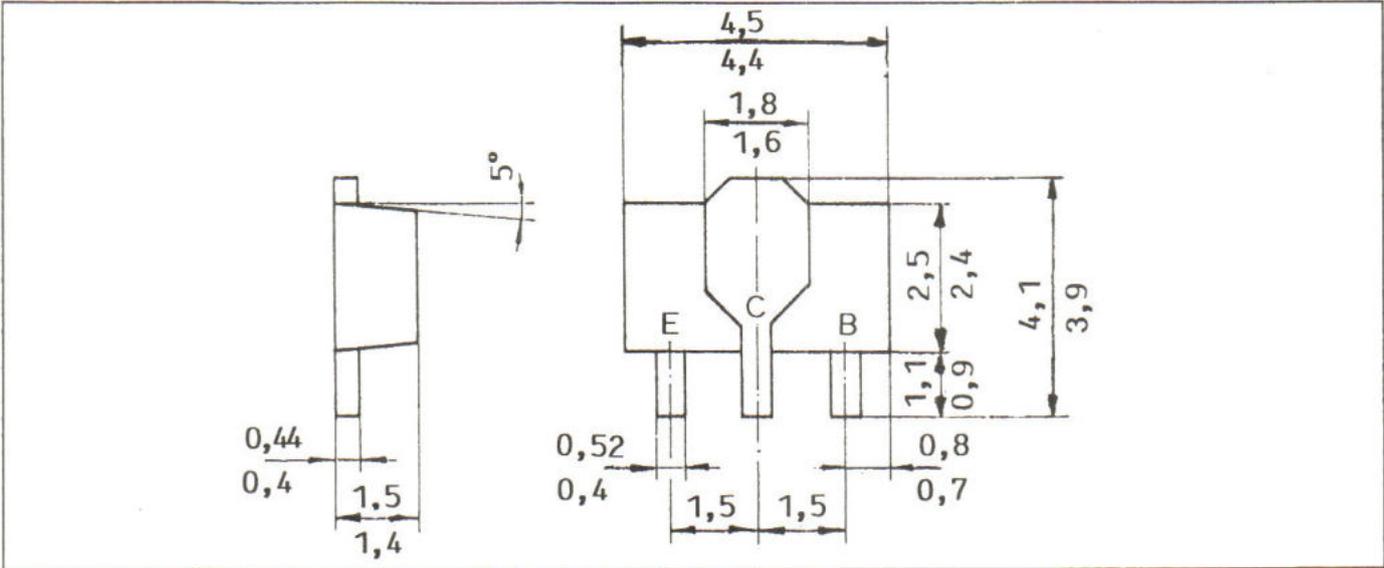


# SFE 570 Si-PNP-Transistor

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistor für Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik.

Mit Komplementärtypen SFE 569 anwendbar in Video-B-Endstufen.



Maßbild mit Anschlußbelegung

Gehäuse: SOT-89

## Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$		250	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CEO}$		250	V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$		5	V
Kollektorstrom	$-I_C$		50	mA
Kollektorspitzenstrom	$-I_{CM}$		100	mA
Gesamtverlustleistung bei $T_{amb} \leq 25 \text{ °C}$ - auf Keramiksuostrat 0,7 mm dick 2,5 cm <sup>2</sup> Fläche	$P_{tot}$		1	W
Sperrschichttemperatur	$T_j$		150	°C
Betriebstemperaturbereich	$T_{stg}$	-55	125	°C

## Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Wärmewiderstände Zwischen Sperrschicht und Umgebung - auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick 2,5 cm <sup>2</sup> Fläche	$R_{thja}$		125	K/W
Zwischen Sperrschicht und Kollektor	$R_{thjc}$		25	K/W

## Ausgewählte Kennwerte ( $T_{amb} = 25\text{ °C}$ )

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$	$I_E = 0$ $-U_{CB} = 200\text{ V}$			50	nA
Kollektor-Emitter-Restspannung	$-U_{CEsat}$	$-I_C = 30\text{ mA}$ $-I_B = 5\text{ mA}$			0,8	V
Gleichstromverstärkung	$h_{FE}$	$-U_{CE} = 20\text{ V}$ $-I_C = 25\text{ mA}$	50			
Transit-Frequenz	$f_T$	$-U_{CE} = 10\text{ V}$ $-I_C = 10\text{ mA}$	60			MHz
Rückwirkungskapazität	$C_{12e}$	$f_M = 20\text{ MHz}$ $-U_{CE} = 30\text{ V}$ $I_C = 0$ $f = 1\text{ MHz}$			1,6	pF